

在 **universal curve** 的表現上將曲線向右移動，也可以降低閘極氧化層的厚度，使通道打開的能力提高，有同樣提高飽和電流的效果，當然調整的過程仍要考慮可靠性等最適化的問題。

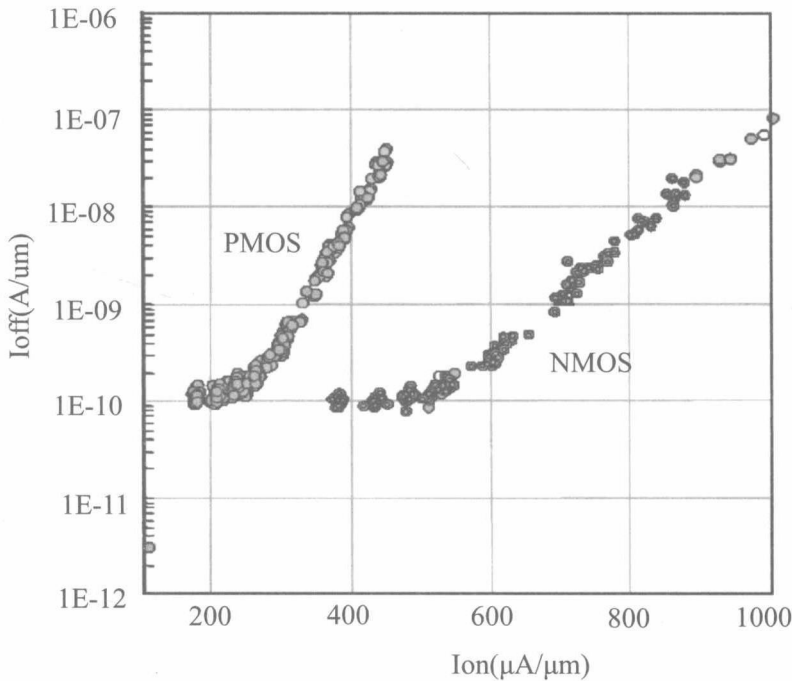


圖 13-13 典型的 90nm 製程的 universal curve。

13.1.2 隔離 (Isolation) 量測

在元件 DC 量測時，除了對主動元件 MOS 相關參數的探討之外，亦可以利用二端元件的阻值量測，來判斷兩點間的開路、短路、漏電流及貫穿電壓等參數。

1. 井到井隔離 (Well to Well Isolation)

用來檢視臨近不同井之間，有無電流洩漏的情形，由於晶片基材多採 p-type 基材，一般無 P-well to P-well 之間隔離的問題，製程開發多設計不同寬度